



СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ
(ГОСКОМИЗОБРЕТЕНИЙ)

АВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 1787589

На основании полномочий, предоставленных Правительством СССР,
Госкомизобретений выдал настоящее авторское свидетельство
на изобретение:
"Способ контроля и сортировки кристаллов
синтетического алмаза"

Автор (авторы): Решетняк Нина Борисовна и Горшков Лев
Капитонович

Заявитель: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА

Заявка № 4872020 Приоритет изобретения 10 октября 1990г.
Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений СССР
15 сентября 1992г.



Действие авторского свидетельства распро-
страняется на всю территорию Союза ССР.

Председатель Комитета

Начальник отдела

Роскоз
Горшков

вх 27/114
17.06.93

4/9 95/90



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1787589 A1

(51)5 B 07 C 5/342, 5/346

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ
ВЕДОМСТВО СССР
(ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

(21) 4872020/12
(22) 10.10.90
(46) 15.01.93. Бюл. № 2
(71) Ленинградский горный институт им.
Г.В.Плеханова
(72) Н.Б.Решетняк и Л.К.Горшков
(56) Новиков Н.В. и др. Физические свойства алмаза. Киев: Наукова думка, 1987, с.188.

(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ И СОРТИРОВКИ
КРИСТАЛЛОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМА-
ЗА

(57) Сущность изобретения: способ контро-
ля и сортировки кристаллов синтетического
алмаза, предусматривающий отбор кри-
сталлов без видимых физических дефектов
и в установленном диапазоне крупности,
воздействие на каждый кристалл выделен-
ной среди них контрольной партии кристал-

2

лов разрушающим усилием с последующим
его измерением, определение предельного
уровня прочности и сортировки кристаллов
по результатам сравнения с ним, перед от-
бором контрольной партии все кристаллы
облучают монохроматическим излучением,
регистрируют индуцированную полосу ком-
бинационного рассеяния с диапазоном значе-
ний 1330 ± 3 см⁻¹ и полосу
фотолюминесценции на длине волны $690 \pm$
10 нм, измеряют интенсивности пика поло-
сы комбинационного рассеяния и интенсив-
ность фотолюминесценции на длине волны
690 нм, вычисляют значения отношений ука-
занных интенсивностей и осуществляют от-
бор по величинам этих значений,
соответствующих предельному уровню
прочности. 1 табл.

Изобретение относится к области буро-
вой, металло- и камнеобрабатывающей тех-
ники, где используются инструменты,
оснащенные природными и синтетическими
алмазами, а также может быть использовано
в кристаллооптике и ювелирном произ-
водстве.

Известен неразрушающий способ оцен-
ки прочностных свойств алмазов, основан-
ный на измерении концентрации оптически
активных азотных дефектов А, В1 и В2, ко-
торые, как показывает практика, наиболее
сильно влияют на прочность алмазов. Одна-
ко для кристаллов синтетического алмаза
этот способ неэффективен, так как указан-
ные выше дефекты присущи только природ-
ным кристаллам.

Наиболее близким к изобретению явля-
ется способ сортировки синтетических ал-
мазов по прочности путем отбора
кристаллов определенного диапазона круп-
ности, основанный на разрушении конт-
рольной партии кристаллов из числа
отобранных, измерении разрушающей на-
грузки, вычислении среднего арифметиче-
ского из полученных значений и оценке по
этому среднему прочностных свойств всей
оставшейся партии кристаллов алмазов.

Недостатком этого способа являются
необходимость разрушать значительное ко-
личество (до 10%) кристаллов в партии, что
приводит к значительным потерям дефици-
тного алмазного сырья, а также низкие эф-
фективность и качество сортировки,
обусловленные большим объемом ручной

(19) SU (11) 1787589 A1

работы. Кроме того, этот способ не может быть использован для улучшения качественных показателей сырья за счет отбора наиболее высокопрочных кристаллов.

Целью изобретения является повышение качества контроля и сортировки кристаллов синтетического алмаза по прочности.

На фиг.1 показаны спектры монохроматического (лазерного) вторичного свечения, то есть полосы комбинационного рассеяния (КР) и фотолюминесценции (ФЛ), зарегистрированные от линии возбуждения 514,5 нм для синтетических алмазов АС-100 с различными разрушающими нагрузками: 265,3 Н (а) и 50,4 Н (б); на фиг.2 изображена графически корреляционная зависимость отношений пиков интенсивности I_2 полосы ФЛ на длине волны 690 нм и интенсивности I_1 полосы КР с частотой $1330 \pm 3 \text{ см}^{-1}$, то есть $I_2/I_1 = K$, где K — безразмерный параметр, зависящий от величины разрушающей нагрузки для испытываемых кристаллов алмаза АС-100 (цифрами отмечены номера образцов кристаллов, испытанных в приведенном примере осуществления способа).

Из предназначенных для сортировки и контроля прочности кристаллов синтетического алмаза, отобранных по установленным диапазонам крупности без видимых физических дефектов, выделяют контрольную партию кристаллов, которые должны пройти воздействие разрушающей нагрузкой с измерением уровня прочности на одноосное сжатие. Перед этим все кристаллы, включая и контрольную партию, облучают монохроматическим (лазерным) излучением и регистрируют индуцированную полосу КР с диапазоном значений $1300 \pm 3 \text{ см}^{-1}$ и полосу ФЛ на длине волны $690 \pm 10 \text{ нм}$, затем измеряют интенсивность пика КР и интенсивность ФЛ на длине волны 690 нм, вычисляют значение отношений указанных интенсивностей, определяют параметр K и осуществляют отбор кристаллов по величинам отношений интенсивностей КР и ФЛ, соответствующим предельным уровням прочности, используя предварительно построенную корреляционную зависимость.

Способ основан на обнаруженной у кристаллов синтетического алмаза обратной корреляции прочности на одноосное сжатие с интенсивностью полосы ФЛ $690 \pm 10 \text{ нм}$. Появление красной полосы ФЛ $690 \pm 10 \text{ нм}$ связано с неазотными дефектами кристаллической решетки алмаза, которые в значительной мере определяют его прочность. Однако, при сравнении абсолютной интенсивности ФЛ возникают ошибки, обуслов-

ленные сложностью учета ряда трудноконтролируемых факторов (характера поверхности образцов, их формы, цвета, размеров, качества юстировки оптики и т.п.).

Для предупреждения этих ошибок абсолютные измерения заменяют относительными, используя в качестве реперной линию пика полосы КР в диапазоне $1330 \pm 3 \text{ см}^{-1}$, которая высвечивается в процессе отклика кристалла на монохроматическое возбуждение наряду с ФЛ. С этой целью и вводится безразмерный параметр K , отмеченный выше.

Способ реализуется следующим образом.

С помощью сил отбирают для испытаний кристаллы алмазов определенных диапазонов крупности. Отобранные кристаллы без какой-либо предварительной обработки помещают один за другим перед входной щелью спектрометра и освещают сфокусированным на любой линии возбуждения пучком монохроматического излучения, например, лазерного, в ультрафиолетовой или видимой области.

Попадание кристалла в фокус луча контролируется по возникновению яркого блика рассеянного излучения. Сигнал вторичного свечения (КР + ФЛ) регистрируют с помощью спектрометра КР, например, типа ДФС производства ЛОМО. При этом вместо записи полного спектра можно ограничиться регистрацией узких участков спектра вблизи максимума полосы КР $1330 \pm 3 \text{ см}^{-1}$ и полосы ФЛ $690 \pm 10 \text{ нм}$, чего достаточно для измерения их интенсивностей (I_1 и I_2). Далее определяют параметр K и сортируют кристаллы по прочности.

Пример. Следует произвести сортировку некоторой партии кристаллов синтетического алмаза АС-100 в количестве 17 образцов по прочности таким образом, чтобы выделить две группы кристаллов с прочностью выше 100 Н и ниже 100 Н, так как по паспорту у этих кристаллов средний показатель прочности на одноосное сжатие составляет в среднем 100 Н.

Исследуемые кристаллы последовательно помещают перед входной щелью спектрометра КР типа RT1-30 фирмы "Дилор" (Франция) и облучают монохроматической линией Ar^+ лазера с длиной волны 514,5 нм (модель 164-06 фирмы "Спектра" Физикс") мощностью 100 мВт. Сигналы вторичного свечения, включающего спектр КР $1330 \pm 3 \text{ см}^{-1}$ и полосу ФЛ $690 \pm 10 \text{ нм}$, регистрируют на ленте самописца с помощью охлаждаемого фотоусилителя ФЭУ типа S-20 в режиме постоянного тока. По полученным

данным рассчитывают параметр К. Далее обращаются к предварительно построенной для контрольной партии кристаллов, прошедших разрушающие испытания на прочность, кривой зависимости параметра К от величины разрушающей нагрузки, откуда следует, что требуемый показатель прочности, равный или больший 100 Н, обеспечивается для кристаллов, у которых $K \leq 0,3$, то есть для образцов №№ 1, 3-6, 9, 11, 12, 16 (всего 9 кристаллов). У остальных кристаллов предполагается прочность ниже 100 Н.

Для контроля правильности измерений прочности производят прямые разрушающие испытания всех 17 кристаллов на динамометре Да-2А (см. таблицу). Как показывают результаты разрушающих испытаний, в группу из 9 кристаллов, где предполагалась прочность, равная или большая 100 Н, попал всего один кристалл с прочностью менее 100 Н (образец № 16 с прочностью 70,1 Н), что свидетельствует о достаточно высокой точности и надежности контроля качества и сортировки синтетических алмазов рассматриваемым способом.

Таким образом, показано, что изобретение пригодно для эффективной сортировки и контроля качества кристаллов синтетического алмаза по прочности. При этом коэффициент корреляции для 17 испытуемых кристаллов, связывающий параметр К с разрушающей нагрузкой, в приведенном примере составил 0,64, что подтверждает наличие корреляционной связи между названными величинами.

Применение изобретения повышает эффективность и качество сортировки син-

тетических алмазов, обеспечивает надежность и объективность получаемых результатов, способствует улучшению технологических качеств алмазного сырья за счет выделения наиболее высокопрочных кристаллов и снижению потерь алмазов при разрушающих испытаниях. Все это создает основу для улучшения технико-экономических показателей алмазного бурения, металло- и камнеобработки.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ контроля и сортировки кристаллов синтетического алмаза, предусматривающий отбор кристаллов без видимых физических дефектов и в установленном диапазоне крупности, воздействие на каждый кристалл выделенной среди них контрольной партии кристаллов разрушающим усилием с последующим его измерением, определение предельного уровня прочности и сортировку кристаллов, отличающийся тем, что, с целью повышения качества сортировки, перед отбором контрольной партии все кристаллы облучают монохроматическим излучением, регистрируют индуцированную полосу комбинационного рассеяния с диапазоном значений $1330 \pm 3 \text{ см}^{-1}$ и полосу фотолюминесценции на длине волны $690 \pm 10 \text{ нм}$, измеряют интенсивности пика полосы комбинационного рассеяния и интенсивность фотолюминесценции на длине волны 690 нм, вычисляют значения отношений указанных интенсивностей и осуществляют отбор по величинам этих значений, соответствующим предельному уровню прочности.

№№ образцов	Параметр К	Разрушающая нагрузка, Н
1	0,28	146,7
2	0,40	92,5
3	0,09	265,3
4	0,10	243,6
5	0,08	178,1
6	0,07	100,1
7	0,34	95,5
8	0,35	62,9
9	0,01	149,6
10	0,38	159,6
11	0,14	216,1
12	0,33	260,6
13	0,38	135,7
14	0,45	50,4
15	0,67	24,8
16	0,26	70,1
17	0,74	49,6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Редактор	Составитель Л.Горшков Техред М.Моргентал	Корректор Е.Копча
----------	---	-------------------

Заказ 28	Тираж	Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5		

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101